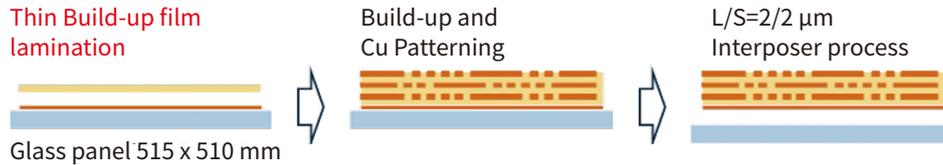


ラミネートプロセス開発の取り組み

Lamination process development efforts.

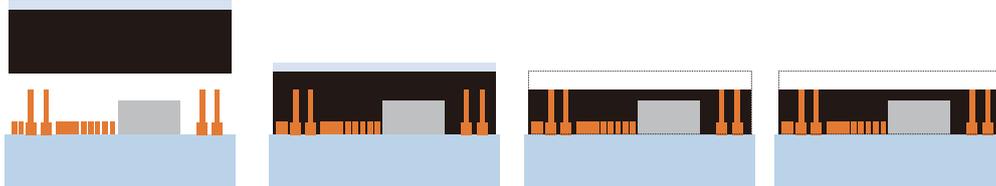
インターポーザプロセス向け極薄層間絶縁樹脂ラミネート/Thin Build up film lamination

L/S=2/2 μ mなどの高密度配線層を形成するインターポーザプロセス適用のために極薄層間絶縁樹脂をラミネート
L/S=2/2 μ m Ultra-thin interlayer insulating resin laminated for application to the interposer process that forms high-density wiring layers



モールド樹脂ラミネート/Mold film lamination

銅 (Cu) ピラーに対してフィルム状モールド樹脂をラミネート
Film-like molding resin is laminated onto copper (Cu) pillars

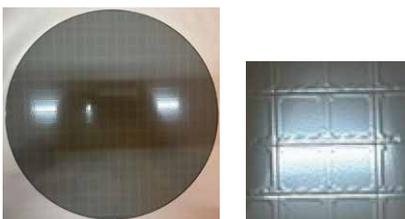


ウェハラミネート/Wafer lamination

フィルムの円形カット可能。ラミネートでは、約2 μ mまでの平坦性を実現しております。
It is also possible to cut the film into a circular shape, achieving a flatness of up to approximately 2 μ m.

Solder Bump Wafer
Bump Diameter : 107 μ m
Bump Height : 80 μ m
Bump Pitch : Area① 170 μ m, Area② 255 μ m

After lamination



After Flat press



		0.853		
		/0.853		
	0.855	0.855	0.853	
	/0.855	/0.855	/0.853	
0.853	0.855	0.853	0.854	0.853
/0.855	/0.854	/0.854	/0.854	/0.855
	0.855	0.854	0.853	
	/0.855	/0.855	/0.855	
		0.853		
		/0.855		
			min	0.853
			MAX	0.855
			Range	0.002

部品内蔵のため樹脂ラミネート/Resin laminate for built-in components

部品内蔵基板に対して樹脂フィルムをラミネート
Laminating a resin film onto a component-embedded board

Film lamination for components embedded

Depth=1400 μ m, width=100 μ m

Film thickness: 150~300 μ m

Film: 150~300 μ m

